

導入年度	H 1 5 年	設備名	EB(Electron Beam)蒸着装置		
メーカー	(株)アルバック	型 式	UEP-4000	設置室	クリーンルーム

《 概 要 》

金属や半導体化合物を真空中で加熱蒸散させ、半導体素子上に電極を形成したり、薄膜センサを製作するために使用する機器

《 装置外観 》



《 仕 様 》

EBガン：1基

抵抗加熱：2基

アークラスマガン：1基

試料サイズ：4inch

到達圧力： 1.3×10^{-5} Pa

基板加熱最高温度：650

水冷による基板冷却が可能

膜厚・真空度の計測およびコンピュータへのデータ収集が可能

《用途例》

- ・電極形成、センサ素子形成
- ・金属、半導体、絶縁体膜形成